

★電子デバイス研究会 (ED)

専門委員長 津田邦男 副委員長 須原理彦
幹事 新井 学・東脇正高 幹事補佐 大石敏之・岩田達哉

★電子部品・材料研究会 (CPM)

専門委員長 廣瀬文彦 副委員長 武山真弓
幹事 岩田展幸・中村雄一 幹事補佐 赤毛勇一

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 国清辰也 副委員長 品田高宏
幹事 黒田理人・山口 直 幹事補佐 池田浩也・諸岡 哲

◎本研究会は参加費が必要になります。

エレソの技報電子化研究会に関する御案内ページ

<https://www.ieice.org/es/jpn/e-gihou-2018es/e-gihou-2018es.htm>

日時 5月24日(木) 13:30~16:40

会場 豊橋技術科学大学ベンチャービジネスラボラトリー (豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1. 豊橋駅東口バス:豊橋技科大線;技科大前下車(約25分), <http://www.vbl.tut.ac.jp/> TEL [0532] 44-6718 岩田達哉)

議題 結晶成長, 評価及びデバイス(化合物, Si, SiGe, 電子・光材料)及びその他

1. フレキシブル有機系熱電変換材料の作製と評価
○岸 直希・日比 聡・吉田祐太・小野恵輔・沢田優真・國枝泰希・近藤雄哉(名工大)
2. Fabrication of Cu-O Thin Films by Galvanostatic Electrochemical Deposition from Weakly Acidic Solutions
○Mansoureh Keikhaei・Masaya Ichimura (NIT)
3. 減圧ドライ転写法によるサスペンデッドグラフェンを用いたMEMSバイオセンサ
○喜種 慎・石田隼斗・澤田和明(豊橋技科大)・高橋一浩(豊橋技科大/JST さきがけ)
4. Growth of high quality InSb channel layer with $In_xGa_{1-x}Sb$ heteroepitaxial films on Si(111)
○A.A. Mohammad Monzur-Ul-Akhir・Masayuki Mori・Koichi Maezawa (Univ. of Toyama)
5. GaN基板上GaNエピ層のFT-IRによる評価 ○堀切文正・成田好伸・吉田丈洋(サイオクス)
6. Siパワーデバイスのプロトン照射欠陥の評価 ○清井 明・湊 忠玄・中村勝光(三菱電機)
7. トンネル状空隙の導入によるSi上Ge層の貫通転位密度低減
○八子基樹(東大)・石川靖彦(豊橋技科大)・和田一実(マサチューセッツ工科大)

☆ED研究会

【問合先】

新井 学(新日本無線)
TEL [049] 278-1441, FAX [049] 278-1269
E-mail: marai@njr.co.jp

東脇正高(NICT)
TEL [042] 327-6092, FAX [042] 327-5527
E-mail: mhigashi@nict.go.jp

☆SDM研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

8月7日(火)~9日(木) 北大〔未定〕テーマ:アナログ, アナデジ混載, RF及びセンサインタフェース回路, 低電圧・低消費電力技術, 新デバイス・回路とその応用

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい。

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

黒田理人(東北大)
TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834
E-mail: rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp